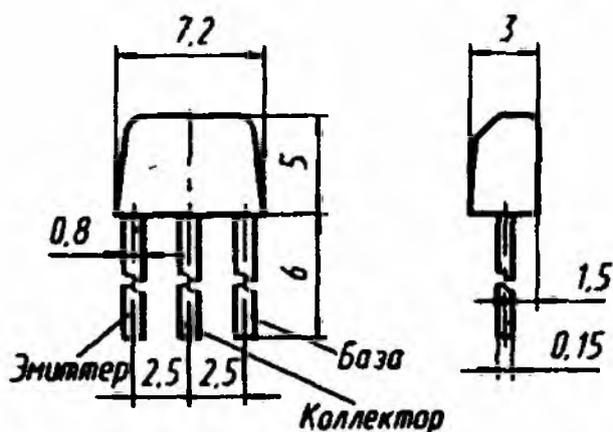


КТ361А, КТ361Б, КТ361В, КТ361Г, КТ361Д, КТ361Е

КТ361(А-Е)



Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры $p-n-p$ усилительные. Предназначены для применения в усилителях высокой частоты. Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами. Тип прибора указывается в этикетке.

Масса транзистора не более 0,3 г.

Изготовители — акционерное общество «Кремний», г. Брянск, завод при НИИПП, г. Томск.

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кб} = 10$ В, $I_k = 1$ мА:

$T = +25$ °С:

КТ361А, КТ361Д.....	20...90
КТ361Б, КТ361Г, КТ361Е	50...350
КТ361В.....	40...160

$T = +100$ °С:

КТ361А, КТ361Д.....	20...250
КТ361Б, КТ361Г, КТ361Е	50...500
КТ361В.....	20...300

$T = -60$ °С:

КТ361А, КТ361Д.....	10...90
КТ361Б, КТ361Г, КТ361Е	15...350
КТ361В.....	10...160

Граничная частота коэффициента передачи тока при $U_{кз} = 10$ В, $I_3 = 5$ мА, не менее..... 250 МГц

Постоянная времени цепи обратной связи при $U_{кб} = 10$ В, $I_3 = 5$ мА, $f = 5$ МГц, не более:

КТ361А, КТ361Б, КТ361Г	500 пс
КТ361В, КТ361Е.....	1000 пс
КТ361Д.....	250 пс

Обратный ток коллектора при $U_{кб} = 10$ В, не более:

$T = +25$ и -60 °С	1 мкА
$T = +100$ °С	25 мкА

Обратный ток коллектор—эмиттер

при $R_{БЭ} = 10 \text{ кОм}$, $U_{КЭ} = U_{КЭ, \text{МАКС}}$, не более 1 мкА

Емкость коллекторного перехода

при $U_{КБ} = 10 \text{ В}$, не более:

КТ361А, КТ361Б 9 пФ

КТ361В, КТ361Г, КТ361Д, КТ361Е 7 пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянные напряжения коллектор—база,
коллектор—эмиттер¹ при $R_{БЭ} = 10 \text{ кОм}$:

$T \leq +35 \text{ }^\circ\text{C}$:

КТ361А 25 В

¹ В диапазоне температур $+35...+100 \text{ }^\circ\text{C}$ допустимое значение напряжения коллектор—эмиттер снижается линейно.

КТ361Б 20 В

КТ361В, КТ361Д 40 В

КТ361Г, КТ361Е 35 В

$T = +100 \text{ }^\circ\text{C}$:

КТ361А 20 В

КТ361Б 15 В

КТ361В, КТ361Д 35 В

КТ361Г, КТ361Е 30 В

Постоянное напряжение база—эмиттер 4 В

Постоянный ток коллектора 50 мА

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора¹:

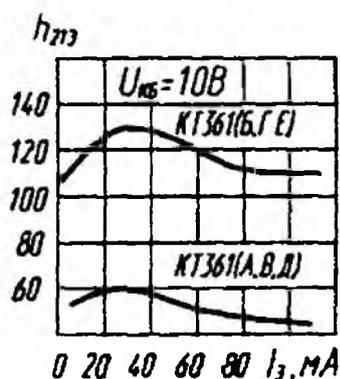
$T \leq +35 \text{ }^\circ\text{C}$ 150 мВт

$T = +100 \text{ }^\circ\text{C}$ 30 мВт

Температура p - n перехода $+120 \text{ }^\circ\text{C}$

Температура окружающей среды $-60...+100 \text{ }^\circ\text{C}$

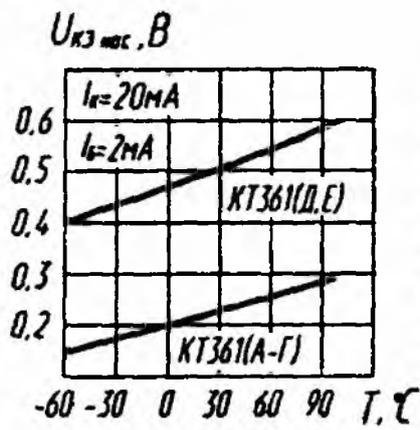
¹ В диапазоне температур $+35...+100 \text{ }^\circ\text{C}$ допустимое значение рассеиваемой мощности снижается линейно.



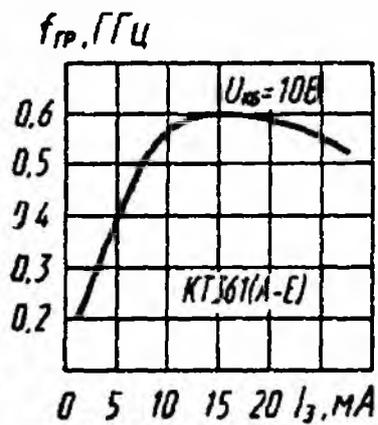
Допускается трехкратный изгиб выводов не ближе 2 мм от корпуса транзистора с радиусом закругления 1,5...2 мм.

Минимально допустимое расстояние от места пайки выводов до корпуса 2 мм.

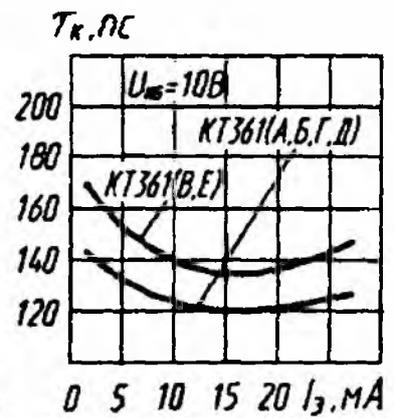
Зависимости статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера



Зависимости напряжения насыщения коллектор—эмиттер от температуры



Зависимость граничной частоты от тока эмиттера



Зависимости постоянной времени цепи обратной связи от тока эмиттера